

2022年(公社)砥粒加工学会賛助会員会 第2回技術交流会のご案内

『パワー半導体と砥粒加工 その2』

— SiC ウェハ加工の動向と最新の加工技術・評価技術 ～加工変質層へのアプローチ～ —

主催：(公社)砥粒加工学会 賛助会員会

【主旨】 砥粒加工学会賛助会員会では、砥粒加工をはじめとしたものづくり技術に関する現状の課題や今後求められる技術について、工具メーカ、機械メーカ、ユーザなどの異なった立場から語り合う場として技術交流会を開催しています。今回は、「SiC ウェハ加工の動向と最新の加工技術・評価技術 ～加工変質層へのアプローチ～」をキーテーマとして、関連する3件の話題提供をいただくとともに、話題提供者を囲んでディープディスカッションを行います。今後、益々の需要増が見込まれるパワー半導体市場において、SiC ウェハの加工プロセスでの取り組みで注目を集めている企業の方を招き、ご講演いただきます。活発で有意義な技術交流会とするために、賛助会員の皆様はもちろんのこと、このテーマに関心をお持ちの幅広い分野の技術者・研究者の皆様にご参加いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

【日時】 2022年8月5日(金) 13:30～17:00 (13:00 開場予定)

【会場】 Cisco Webex Meeting を用いてオンライン開催いたします。

【内容】 13:30～13:35 開会挨拶

13:35～14:25 SiC ウェハ加工プロセス全方位における加工変質層の取り扱いについて

講演者：株式会社ミライズテクノロジーズ 長屋正武 氏

14:30～15:20 先進パワー半導体基板の研磨プロセスと表面品位

講演者：株式会社斉藤光学製作所 千葉翔悟 氏

15:20～15:30 (休憩)

15:30～16:20 SiC ウェハ最新の検査技術と加工変質層の評価手法

講演者：レーザーテック株式会社 藤木翔太 氏

16:25～16:55 ディープディスカッション

16:55～17:00 閉会挨拶

*ディープディスカッションの質問は直前までに主催者側で質問をとりまとめる予定です。

講師の方々に質問がある方は、主催者側へチャット入力をお願いいたします。

【参加費】 無料

【定員】 200名(先着順ですが、回線に限りがありますので、賛助会員の方を優先して受け付けます)

【申込締切】 2022年7月22日(金) ⇒ 7月28日(木) に延長しました。

【申込み先】 下記のお申込み用WEBサイトよりお申込みください。

https://www.jsat.or.jp/Sanjo_TEM220805

【問合せ先】 (公社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17 セラミックビル4F

TEL: 03-3362-4195, FAX: 03-3368-0902, E-mail: staff@jsat.or.jp

2022年度 賛助会員会 第2回技術交流会 参加申込書

※WEBサイトからお申込みできない場合は、以下にご記入の上、staff@jsat.or.jpへお申込みください。

住所			
勤務先・所属			
参加者氏名			
会員資格	(いずれかに○) 賛助会員 正会員 学生 非会員		
Tel		Fax	
E-mail			
備考			

・1回線で複数の方がご聴講いただく場合、お申し込みは代表者のみで結構です。

・複数の方がそれぞれの回線でご聴講の場合は、おひとり様ずつお申し込みください。